

トランジスタ

2SD1291

2SD1291

T-33-11

シリコン NPN 三重拡散メサ形/Si NPN Triple Diffused Mesa

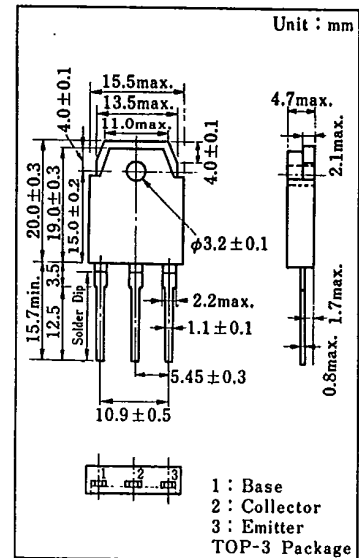
カラーテレビ水平偏向出力用/Horizontal Deflection Output for Color TV Set

■ 特徴/Features

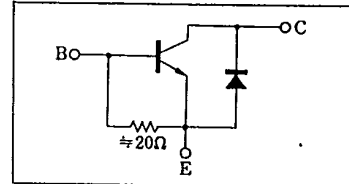
- ダンパダイオード内蔵。/ Built-in damper diode on chip
- ガラスパッシベーションによる高耐圧、高信頼性。/ High voltage and high reliability by glass passivation.
- 安全動作領域(ASO)が広い。/ Wide area of safe operation (ASO)

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CES}	1500	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	5	A
コレクタ電流	I_C	3	A
コレクタ損失 (Tc=25 °C)	P_C	65	W
接合部温度	T_J	130	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +130	°C



内部接続図/Connection Diagram



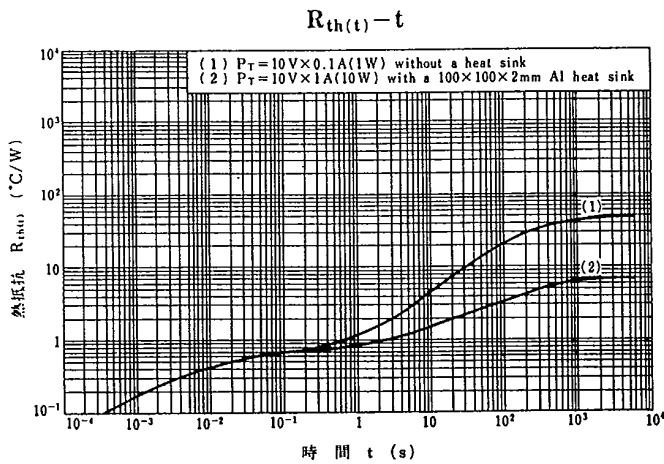
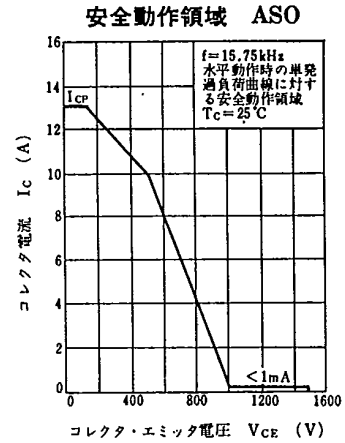
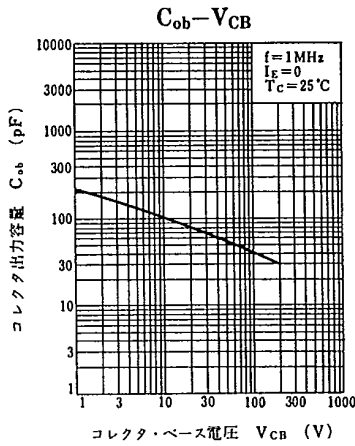
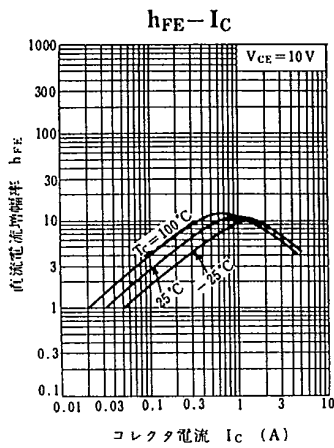
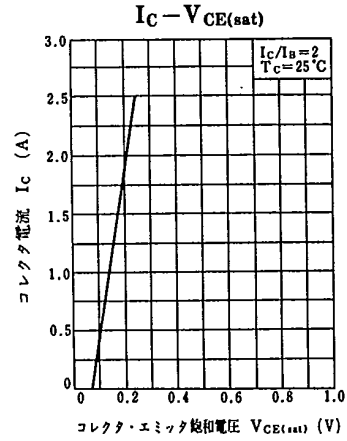
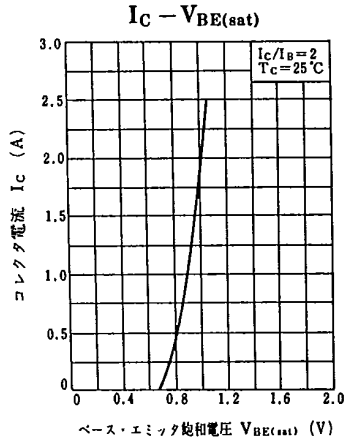
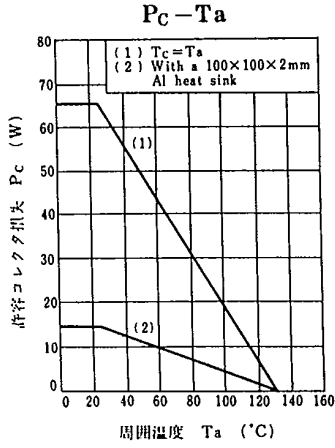
■ 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=750\text{ V}, I_E=0$			50	μA
		$V_{CB}=1500\text{ V}, I_E=0$			1	mA
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=500\text{ mA}, I_C=0$	5			V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=10\text{ V}, I_C=2.5\text{ A}$	3		12	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2.5\text{ A}, I_B=0.8\text{ A}$			5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=2.5\text{ A}, I_B=0.8\text{ A}$			1.5	V
蓄積時間	t_{stg}	$I_C=2.5\text{ A}, I_{Bend}=0.8\text{ A}, L_B=5\text{ }\mu\text{H}$	4		8	μs
下降時間	t_f					
ダイオード順電圧	V_F	$-I_C=4\text{ A}, I_B=0$			2.2	V

トランジスタ

2SD1291

T-33-11



PANASONIC INDL/ELEK{SEMI} 72C D 6932854 0009618 9

トランジスタ

2SD1304

2SD1304

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

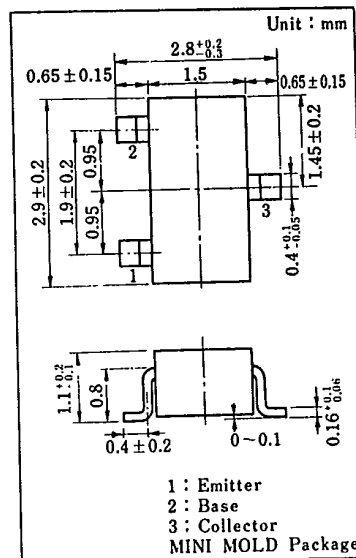
低周波増幅用 / AF Amplifier

■ 特徴 / Feature

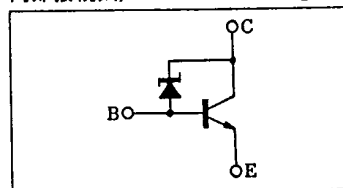
- ツェナーダイオード内蔵。 / Built-in zener diode on chip

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	20 ± 3	V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	20 ± 3	V
エミッタ・ベース電圧	V _{EBO}	7	V
せん頭コレクタ電流	I _{CP}	200	mA
コレクタ電流	I _C	100	mA
コレクタ損失	P _C	200	mW
接合部温度	T _J	125	°C
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +125	°C



内部接続図 / Connection Diagram



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	V _{CB} = 10 V, I _E = 0			0.1	μA
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	I _C = 1 mA, I _B = 0	17		23	V
エミッタ・ベース電圧	V _{EBO}	I _E = 10 μA, I _C = 0	7			V
直流電流増幅率	h _{FE1} *	V _{CE} = 10 V, I _C = 2 mA	160		460	
	h _{FE2}	V _{CE} = 2 V, I _C = 100 mA	90			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = 100 mA, I _B = 10 mA			0.5	V

* h_{FE1} ランク分類 / h_{FE1} Classifications

Class	Q	R	S
h _{FE1}	160 ~ 260	210 ~ 340	290 ~ 460
Marking Symbol	2AQ	2AR	2AS

トランジスタ

2SD1304

T-29-15

